

2SD721, 2SD722

■シリコンNPN三重拡散メサ形トランジスタ

☆2SB711、2SB712とコンプリメンタリペアになります。

☆ダーリントトランジスタ

☆レジンモールドケース

○一般用

○通信産業用

■最大定格 (Ta=25°C)

項 目	記 号	2SD721	2SD722
コレクタ・ベース電圧	V _{CB0}	100 V	120 V
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CE0}	80 V	100 V
エミッタ・ベース電圧	V _{EB0}	6 V	
コレクタ電流	I _C	6 A (*Pulse10A)	
ベース電流	I _B	1 A	
許容コレクタ損失	P _C	50 W (フランジ温度25°C)	
接合部温度	T _j	150°C	
保存温度	T _{stg}	-55 ~ +150°C	

*Pulse:10mSec.以下, Duty cycle 50%以下

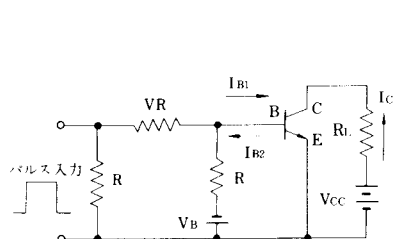
■電気的特性 (Ta=25°C)

項 目	記 号	試 験 条 件	2SD721	2SD722
最大コレクタしや断電流	I _{CBO}	V _{CB} =	100 μA	100 μA
			100 V	120 V
最大エミッタしや断電流	I _{EBO}	V _{EB} = 6 V	10 mA	
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CE0}	I _C = 10 mA	80 V	100 V
直流電流増幅率	h _{FE}	V _{CE} = 4 V I _C = 7 A	500 Min.	
コレクタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C = 5 A I _B = 10 mA	1.5 V Max.	

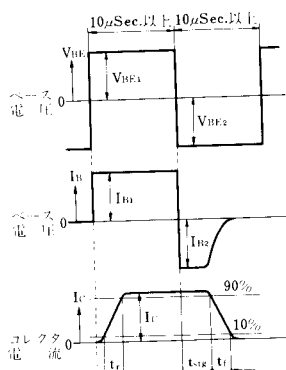
■代表的スイッチング特性 (エミッタ接地)

V _{CC} (V)	R _L (Ω)	I _C (A)	I _{B1} (mA)	I _{B2} (mA)	t _r (μSec.)	t _{stg} (μSec.)	t _f (μSec.)
20	4	5	20	-20	1.8	5.5	11

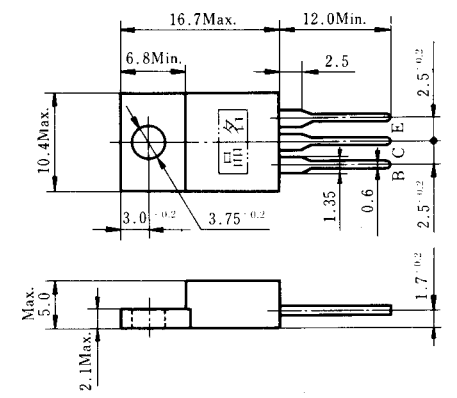
スイッチング特性測定回路



測定条件



外形寸法 (単位: mm)



周囲温度と最大許容損失

